

ОВФ ЗВУКА В ДВУСЛОЙНОЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СРЕДЕ

А.П. Брысов, В.Н. Стрельцов

Рассмотрено стационарное распространение падающей извне плоской акустической волны в системе двух плоскопараллельных ОВФ слоев с заданным коэффициентом отражения на границе между ними.

В связи с проблемой ОВФ звука в параметрических средах представляет интерес вопрос о прохождении звуковой волны через границу раздела двух сред с различными акустическими импедансами и параметрическими свойствами. Ниже для случая нормального падения пучка получены общие выражения для прошёдшей и отраженной волн и исследована зависимость их амплитуд от параметров слоев. Определены критические значения последних, приводящие к неустойчивости.

Пусть на бесконечный по поперечным координатам двойной плоскопараллельный слой падает нормально плоская акустическая волна частоты ω . Невозмущенные скорости звука в слоях с толщинами l_1 и l_2 считаем соответственно равными c_{01} , c_{02} . Предполагаем, что система находится во внешних полях, так что скорости звука c_1 , c_2 испытывают пространственно однородную модуляцию: $c_{1,2} = c_{01,2}(1 + 2\mu_{1,2}X \cos 2\omega t)$. Амплитудный коэффициент отражения на плоскости раздела слоев для первого слоя примем равным $R_1 = R$; тогда для второго слоя $R_2 = -R$. Для стационарного режима уравнения для медленных амплитуд волн, распространяющихся в направлении падающей волны ($U_{1,2}^+(z)$) и навстречу ей ($U_{1,2}^-(z)$), в пренебрежении затуханием имеют вид

$$dU_{1,2}^*/dz = -i\mu_{1,2}k_{1,2}U_{1,2}^-, \quad dU_{1,2}^-/dz = -i\mu_{1,2}k_{1,2}U_{1,2}^{**}, \quad (1)$$

где $k_{1,2} = \omega/c_{01,2}$. Границные условия при согласовании входного и выходного импедансов первого и второго слоя имеют вид:

$$\begin{aligned} U_1^+(0) &= U_0, \quad U_1^-(l_1) = RU_1^+(l_1)e^{-2ik_1 l_1} + (1-R)U_2^-(l_1)e^{il_1(k_2-k_1)}, \\ U_2^-(l_1 + l_2) &= 0, \quad U_2^+(l_1) = (1+R)U_1^+(l_1)e^{il_1(k_2-k_1)} - RU_2^-(l_1)e^{2ik_1 l_1}, \end{aligned} \quad (2)$$

где U_0 — амплитуда падающей волны на входной границе первого слоя ($z = 0$). Решение (1), (2) дает следующие выражения для выходных амплитуд $U_2^+(l_1 + l_2)$ и $U_1^-(0)$:

$$\begin{aligned} U_2^+(l_1 + l_2) &= (2/\Delta) [U_0 e^{il_1(k_2-k_1)} ((1+ReR)\cos\mathcal{L} + iImR\cos l) - \\ &- iU_0^* e^{il_1(k_2+k_1)} ((|R|^2 + ReR)\sin l + iImR\sin\mathcal{L})], \\ U_1^-(0) &= (1/\Delta) [2U_0 e^{-2il_1 k_1} (ReR\cos(\mathcal{L}+l) + iImR) + \\ &+ iU_0^* (\sin 2\mathcal{L} - |R|^2 \sin 2l - 2iImR \sin(\mathcal{L}+l))]. \end{aligned} \quad (3)$$

Здесь $\Delta = 1 + \cos 2\mathcal{L} - |R|^2(1 - \cos 2l)$, $\mathcal{L} = \mu_1 k_1 l_1 + \mu_2 k_2 l_2$, $l = \mu_2 k_2 l_2 - \mu_1 k_1 l_1$.

Из (3) следует, что прямая $U_2^+(l_1 + l_2)$ и обратная $U_1^-(0)$ волны содержат как компоненты с фазой падающей волны, так и обращенную компоненту ($\propto U_0^*$). В прямой волне обращенная компонента испытывает дополнительный набег фаз, определяемый толщиной первого слоя. Эта компонента для вещественных R возникает лишь при неравных эффективных длинах $(\mu k l)_{1,2}$ слоев, возрастая с увеличением их разности l . В обратной волне обращенная компонента существует и при $l = 0$. Условие самовозбуждения в системе отвечает $\Delta = 0$ и не зависит от скачка фазы на границе раздела. При фиксированной полной толщине слоя L необходимое условие самовозбуждения накладывает ограничения на эффективные толщины каждого из слоев: $|R|^{-1} \cos L \leq \max|\sin(\mu_1 k_1 l_1), \sin(\mu_2 k_2 l_2)|$. Достаточное условие возбуждения дается равенством $\sin l = \pm |R|^{-1} \cos L$, которое симметрично относительно перестановки слоев. Далее считаем коэффициент отражения R вещественным и рассмотрим некоторые частные случаи.

1. Равные эффективные толщины слоев: $2\mu_1 k_1 l_1 = 2\mu_2 k_2 l_2 = L$. При этом $U_1^-(0) = U_0 e^{-2ik_1 l_1} R / \cos L + iU_0^* \operatorname{tg} L$, $U_2^+(l_1 + l_2) = U_0 e^{il_1(k_2 - k_1)} (1 + R) / \cos L$, и интерференция волн приводит к гашению обращенной компоненты в прямой волне на выходе второго слоя. Наличие отражения в системе, как и в случае пассивных сред, приводит по сравнению с однородным ОВФ слоем к изменению выходной амплитуды этой волны, определяемому пассивным коэффициентом пропускания $T = 1 + R$. В обратной волне обращенная компонента остается такой же, как и в однородном слое. Амплитуда необращенной компоненты оказывается пропорциональной R . Условие самовозбуждения имеет такой же вид, как и в отсутствие отражения: $L = \pi/2$.

2. Малая эффективная толщина первого слоя: $L_1 = \mu_1 k_1 l_1 \ll 1$. Раскладывая (3) в ряд по L_1 и считая $2L_2 \sim 1$, получаем соотношение критических параметров L_1, L_2 , приводящих к самовозбуждению: $(1 - 2L_1 \sin 2L_2)(R^2 - 1)/(R^2 + 1) = \cos 2L_2$, $L_2 = \mu_2 k_2 l_2$. Асимметрия в эффективных толщинах слоев приводит к зависимости критических длин от коэффициента отражения. Критическая длина L_2 при фиксированном R монотонно убывает с ростом L_1 : линейная по L_1 поправка к L_2 равна: $\Delta L_2 = (R^2 - 1)(R^2 + 1)^{-1} \times L_1$. Вдали от порога выходные стационарные амплитуды прямой и обратной волн при небольших коэффициентах отражения можно представить в виде:

$$\begin{aligned} U_2^+(l_1 + l_2) &\approx (1/\cos L_2) [U_0 e^{il_1(k_2 - k_1)} (1 + L_1 \operatorname{tg} L_2 + R^2 \operatorname{tg}^2 L_2 + L_1 R \operatorname{tg} L_2) - \\ &- iU_0^* e^{il_1(k_2 + k_1)} R ((1 + R) \operatorname{tg} L_2 + (2 \operatorname{tg}^2 L_2 - 1) L_1)], \\ U_1^-(0) &\approx U_0 e^{-2il_1 k_1} (R/\cos^2 L_2) (1 + 2L_1 \operatorname{tg} L_2) \cos 2L_2 + \\ &+ iU_0^* (\operatorname{tg} L_2 + (1 - \operatorname{tg}^2 L_2) L_1 - R^2 \operatorname{tg}^2 L_2). \end{aligned}$$

3. Малая эффективная толщина второго слоя: $L_2 = \mu_2 k_2 l_2 \ll 1$. После разложения (3) в ряд по L_2 вдали от порога находим:

$$\begin{aligned} U_2^+(l_1 + l_2) &\approx (1/\cos L_1) [U_0 e^{il_1(k_2 - k_1)} (1 + L_2 \operatorname{tg} L_1 + R^2 \operatorname{tg}^2 L_1 + L_2 R \operatorname{tg} L_1) - \\ &- iU_0^* e^{il_1(k_2 + k_1)} R ((1 + R) \operatorname{tg} L_1 + (2 \operatorname{tg}^2 L_1 + 1) L_2)], \\ U_1^-(0) &\approx U_0 e^{-2il_1 k_1} (R/\cos^2 L_2) (1 + 2L_2 \operatorname{tg} L_1) + \\ &+ iU_0^* (\operatorname{tg} L_1 + (1 - \operatorname{tg}^2 L_1) L_2 - R^2 \operatorname{tg}^2 L_1). \end{aligned}$$

Зависимость от L_1, L_2 необращенной компоненты в прямой волне и обращенной в обратной такая же, как в п. 2 с заменой L_1 на L_2 соответственно. Линейный по L_2 рост амплитуды обращенной компоненты прямой волны более резкий, чем аналогичный рост по L_1 этой же компоненты в п. 2. Амплитуда необращенной компоненты в $U_1^-(0)$ при малой толщине первого слоя отличается от приведенного здесь значения соответствующей компоненты наличием дополнительной зависимости от толщины наибольшего слоя, определяемой множителем $\cos 2L_2$.

Остановимся на вопросе о возможности интерференционного гашения отдельных компонент в выходных амплитудах волн. Из (3) следует, что такое гашение можно осуществить для всех компонент, за исключением обратной обращенной.

Гашение необращенной компоненты в $U_1^-(0)$ возникает при $\mathcal{L}_2 = \pi/4$. Вдали от порога самовозбуждения ($R \neq 1, \mathcal{L}_1 < \pi/4$) амплитуды ненулевых компонент зависят только от толщины первого слоя:

$$U_1^-(0) = iU_0^* \cos 2\mathcal{L}_1 / (1 - \sin 2\mathcal{L}_1),$$

$$U_2^+(l_1 + l_2) = 2[U_0 e^{il_1(k_2 - k_1)} \cos(\mathcal{L}_1 + \pi/4) + iU_0^* e^{il_1(k_2 + k_1)} R \sin(\mathcal{L}_1 - \pi/4)] / (1 - R)(1 - \sin 2\mathcal{L}_1).$$

Гашение необращенной компоненты в прямой волне реализуется при $\mathcal{L} = \pi/2$, при этом ненулевые амплитуды компонент волн определяются вдали от порога значением l :

$$U_1^-(0) = U_0 e^{-2il_1 k_1} / R \sin l + iU_0^* / \tan l,$$

$$U_2^+(l_1 + l_2) = iU_0^* e^{il_1(k_2 + k_1)} (1 + R) / R \sin l.$$

Гашение обращенной компоненты в $U_2^+(l_1 + l_2)$ происходит при $l = 0$. Остальные компоненты вдали от порога зависят от суммарной толщины слоя:

$$U_2^+(l_1 + l_2) = U_0 e^{il_1(k_2 - k_1)} (1 + R) / \cos \mathcal{L}, \quad U_1^-(0) = U_0 e^{-2il_1 k_1} R / \cos \mathcal{L} + iU_0^* \tan \mathcal{L}.$$

Рассмотренные особенности распространения акустической волны в двуслойной среде качественно демонстрируют возможные влияния неоднородностей на процессы параметрического взаимодействия звуковых пучков в ОВФ средах.

Институт общей физики АН СССР

Поступила в редакцию 21 сентября 1988 г.